|  |  |
| --- | --- |
| 文章标题 | 雪崩击穿电压高达600V，一款FTO-220A封装的低导通电阻MOSFET |
| 市场/应用 | 电源转换器电路，继电器驱动，逆变器 |
| 关键词 | VDSS, 导通电阻, 漏极/源极电压, 耗散功率, 电荷量, Id |
| 摘要 | F11F60CPM/F16F60CPM/F21F60CPM/F25F60CPM是新电元公司推出的一款性能优异的面向开关电源的N沟道金属氧化物场效应晶体管，性能稳定可靠，具有高电压，低导通电阻，高切换速度的特点，是设计中大功率开关电源的理想选择。广泛使用于电源转换器电路，继电器驱动，逆变器等应用。 |

F11F60CPM/F16F60CPM/F21F60CPM/F25F60CPM是新电元公司推出的一款性能优异的面向开关电源的N沟道金属氧化物场效应晶体管，相对于P沟道MOS管，导通电阻更小，并且容易制造。最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为600.0V，最大漏极持续电流（DC）Id为11.0/16.0/21.0/25.0A，性能稳定可靠，具有高电压，低导通电阻，高切换速度的特点，是设计中大功率开关电源的理想选择。广泛使用于电源转换器电路，继电器驱动，逆变器等应用。

采用SMD（Surface Mounted Devices）表面贴装，以Sn为主要材料，大多采用内箱直径为180mm的Tape & Reel带卷式封装。具体封装形态为FTO-220A，是一款具体尺寸为28.5mm（W）X10.0mm（H）X4.5mm（D）mm，适用于小型嵌入式电器设计。

图1 F11F60CPM外部视图

F11F60CPM/F16F60CPM/F21F60CPM/F25F60CPM的最大栅极/源极电压VGSS为±30V，最大耗散功率Pd为50.0/55.0/60.0/70.0W，提高了能源利用效率，同时保障了MOSFET在高功率场合下的可靠性和稳定性。其静态漏源导通电阻Rds典型值为0.27/0.18/0.15/0.11Ω，最高沟道温度Tch为150.0℃，总栅极电荷量典型值Qg为22.0/33.0/39.0/53.0 nC。

图2 F11F60CPM典型输出特性及转移特性曲线

﻿

F11F60CPM/F16F60CPM/F21F60CPM/F25F60CPM的主要特点：

• 最大漏极/源极电压VDSS（雪崩击穿电压）为600.0V，最大栅极/源极电压VGSS为±30V

• 最大漏极持续电流（DC）Id为11.0/16.0/21.0/25.0A，最大耗散功率Pd为50.0/55.0/60.0/70.0W

• 静态漏源导通电阻Rds典型值为0.27/0.18/0.15/0.11Ω

• 最高沟道温度Tch为150.0℃

• 总栅极电荷量典型值Qg为22.0/33.0/39.0/53.0 nC

• 采用FTO-220A封装, 尺寸大小为28.5mm（W）X10.0mm（H）X4.5mm（D）

F11F60CPM/F16F60CPM/F21F60CPM/F25F60CPM的典型应用：

• 电源转换器电路

• 继电器驱动

• 逆变器